

19444

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Januar 2004 (08.01.2004)

PCT

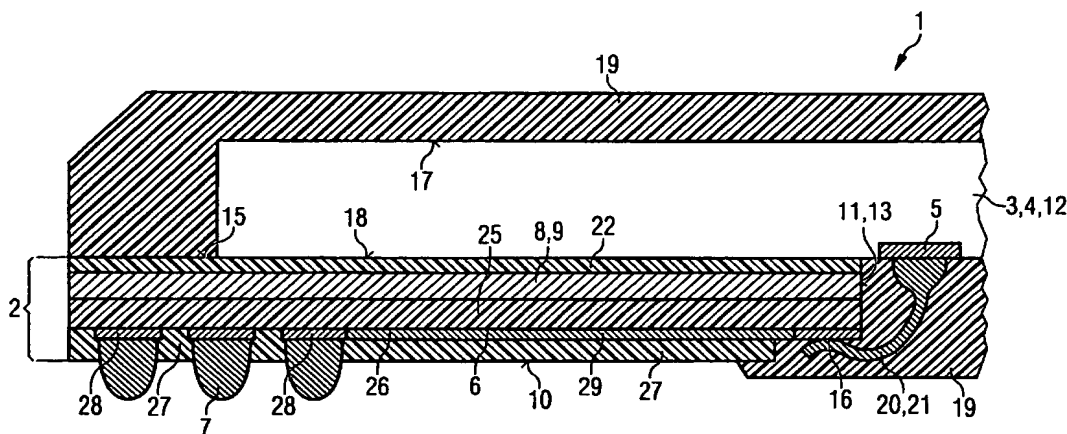
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/004006 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 23/552**,
23/498, G11C 11/15
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002162
- (22) Internationales Anmeldedatum:
30. Juni 2003 (30.06.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
102 29 542.5 1. Juli 2002 (01.07.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **INFINEON TECHNOLOGIES AG** [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **THOMAS, Jochen**
[DE/DE]; Ottilienstr. 46 A, 81827 München (DE). **WEN-**
NEMUTH, Ingo [DE/DE]; Josephsburgstr. 146 A, 81825
München (DE).
- (74) Anwalt: **SCHWEIGER, Martin**; c/o Schweiger & Part-
ner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaat (national): US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A MULTILAYER WIRING FRAME AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: ELEKTRONISCHES BAUTEIL MIT MEHRSCHICHTIGER UMVERDRAHTUNGSPLATTE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN



(57) Abstract: The invention relates to an electronic component (1) comprising a multilayer wiring frame (2) that carries a circuit chip (3), especially a magnetic memory chip (4) and that links the contact surfaces of the chip (5) with the external contacts (7) of the electronic component (1) via internal wires (6). The wiring frame (2) comprises at least one structured magnetic shielded layer (8) that consists of an amorphous metal or an amorphous metal alloy. The invention further relates to a method for producing said electronic component (1).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil (1) mit einer mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte (2), die einen Schaltchip (3), insbesondere einen magnetischen Speicherchip (4) trägt und Kontaktflächen des Chips (5) über Umverdrahtungsleitungen (6) mit Außenkontakten (7) des elektronischen Bauteils (1) verbindet. Die Umverdrahtungsplatte (2) weist mindestens eine strukturierte magnetische Abschirmschicht (8) aus einem amorphen Metall oder einer amorphen Metall-Legierung auf. Ferner umfasst die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung dieses elektronischen Bauteils (1).

WO 2004/004006 A1



— *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Elektronisches Bauteil mit mehrschichtiger Umverdrahtungsplatte und Verfahren zur Herstellung desselben.

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit einer mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte, die einen Schaltungschip, insbesondere einen magnetischen Speicherchip trägt und ein Verfahren zur Herstellung desselben.

10

Elektronische Bauteile mit einem Halbleiterchip, insbesondere mit einem magnetischen Speicherchip, sind durch magnetische Felder aus dem Umfeld der elektronischen Bauteile, wie Transformatoren, Netzgeräte, Gebläsemotoren und dergleichen besonders gefährdet, wobei unbeabsichtigte Schaltvorgänge in den Schaltungschips ausgelöst werden können. Magnetische Störungen von nur wenigen Zehntel Oerstedt können bereits Fehlfunktionen auslösen, zumal die Schwellenwerte für eine logische Null und eine logische Eins mit zunehmender Miniaturisierung der Schaltungszellen ständig minimiert werden. Während elektronische Bauteile auf der Basis von Flachleiterrahmen durch die metallischen Strukturen eine begrenzte Schutzwirkung aufweisen, entfällt diese vollständig bei elektronischen Bauteilen auf der Basis von BGA-Typ-Gehäusen (Ball-Grid-Array-Typ).

25

Abschirmungen auf der Basis von Permalloy oder Alloy 42 haben den Nachteil einer zur Abschirmung von Großgeräten hohen Remanenz, so dass diese Materialien sich wie ein Permanentmagnet verhalten, das heißt, nachdem sie einem Magnetfeld ausgesetzt wurden, bilden sie ein permanentes eigenes Magnetfeld aus und können damit die Funktionstüchtigkeit von elektronischen Bauteilen mit einem Schaltungschip beeinträchtigen oder auf Dauer schädigen. Deshalb kann der Einsatz von Flachlei-

30

terrahmen aus derartigen Materialien oder Abschirmgehäusen aus Materialien mit hoher Remanenz die gewollte Abschirmwirkung für elektronische Bauteile mit einem Schaltungschip in das Gegenteil umkehren, so dass der Schaltungschip dauernd durch ein verbleibendes Restmagnetfeld aufgrund der hohen Remanenz dieser Materialien geschädigt wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein elektronisches Bauteil anzugeben, das eine Struktur aufweist, die den Schaltungschip vor magnetischen Störfeldern schützt und Fehlfunktionen aufgrund von magnetischen Störungen im Bereich von mehreren Oerstedt vermindert ohne die Funktionsfähigkeit des elektronischen Bauteils einzuschränken.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Erfindungsgemäß wird ein elektronisches Bauteil mit einer mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte angegeben, die einen Schaltungschip insbesondere einen magnetischen Speicherchip trägt. Die Umverdrahtungsplatte weist Umverdrahtungsleitungen auf, die Kontaktflächen des Chips mit Außenkontakten des elektronischen Bauteils verbinden. Mindestens eine der strukturierten Schichten der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte ist eine magnetische Abschirmschicht, welche ein amorphes Metall oder eine amorphe Metall-Legierung aufweist.

Eine derartige Abschirmschicht aus einem amorphen Metall oder einer amorphen Metall-Legierung ist mechanisch äußerst hart und gibt der Umverdrahtungsplatte eine hohe Formstabilität. Gleichzeitig sind amorphe magnetische Metalle oder amorphe magnetische Metall-Legierungen weichmagnetisch, was den Vor-

teil hat, dass diese Materialien nicht durch ein Magnetfeld polarisiert werden können und somit keine Permanentmagnetwirkung ausbilden. Darüber hinaus wird durch die Anordnung des amorphen Metalls oder der amorphen Metall-Legierung als

5 Schicht einer Umverdrahtungsplatte erreicht, dass die magnetische Abschirmschicht in unmittelbarer Nähe des zu schützenden Schaltungschips angeordnet werden kann, ohne das Herstellungsverfahren für die Schaltungschips selbst zu ändern oder anzupassen. Es muss lediglich eine weitere strukturierte

10 Schicht in der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte vorgesehen werden.

Durch die Maßnahme, ein magnetisch abschirmendes amorphes Metall oder eine amorphe Metall-Legierung als weitere Schicht

15 in eine mehrschichtige Umverdrahtungsplatte zu integrieren, werden insbesondere Schaltungschip mit magnetischen Speicherzellen vor magnetischen Störfeldern geschützt. Somit können insbesondere sogenannte MRAM (Magnetic-Random-Access-Memories) Bauteile, mit denen der sogenannte TMR (Tunnel-

20 Magneto-Resistive)- oder der GMR (Giant-Magneto-Resistive)- zum Speichern von Daten genutzt wird, vor magnetischen Störfeldern geschützt werden. Bei diesen Bauteilen wird eine weich- beziehungsweise hartmagnetische Lage entweder parallel oder antiparallel geschaltet, wobei eine Parallelschaltung

25 einen niedrigen Durchgangswiderstand und eine Antiparallelschaltung einen hohen Durchgangswiderstand bedeutet, so dass die Speicherfunktion Null und Eins realisiert werden kann. Dabei dient die weichmagnetische Schicht als Schalter und die hartmagnetische Schicht als Referenzschicht. Für das Schalten

30 der weichmagnetischen Schicht stehen jedoch nur begrenzt hohe Ströme zur Verfügung, so dass die Koerzitivfeldstärke so niedrig wie möglich zu halten ist. Somit sind diese Schaltzustände in der weichmagnetischen Schicht äußerst störanfällig

und Fehlfunktionen derartiger MRAM-Bauteile werden schon bei magnetischen Feldern von wenigen Zehntel Oerstedt beobachtet.

5 Mit Hilfe der erfindungsgemäßen mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte, die eine magnetische Abschirmschicht aus einem amorphen ferromagnetischen Metall oder einer amorphen ferromagnetischen Metall-Legierung aufweist können Störfelder von mehreren Oerstedt im Umfeld des elektronischen Bauteils, die von Transformatoren, Netzgeräten oder Gebläsemotoren verursacht werden, abgeschirmt werden.

10 Wenn auch der Einsatz der erfindungsgemäßen Umverdrahtungsplatte in elektronischen Bauteilen mit magnetischen Speicherzellen besonders wirkungsvoll ist, und die Funktionsfähigkeit derartiger elektronischer Bauteile erst gewährleistet, ohne dass große Abschirmgehäuse für derartige elektronische Bauteile vorgesehen werden, kann eine derartige mehrschichtige Umverdrahtungsplatte auch vorteilhaft für Schaltungschips, die herkömmliche Speicherzellen aufweisen oder auch für Logikchips eingesetzt werden, zumal aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit dieser amorphen Metalle auch eine Abschirmwirkung gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, welche die Speicher- und Schaltfunktionen beeinflussen können, erfolgt. Dazu wird lediglich die magnetische Abschirmschicht in ihrer Struktur der Umverdrahtungsplatte für die unterschiedlichen Schaltungstypen angepasst.

30 Als Abschirmschicht kann eine strukturierte Abschirmfolie mit einer Dicke zwischen 20 und 75 Mikrometern eingesetzt werden. Derartige Abschirmfolien aus amorphen ferromagnetischen Metallen oder Metall-Legierungen werden in Bandform hergestellt und eignen sich besonders zur Auflaminierung auf den Isolationkern einer Umverdrahtungsplatte. Dazu muss lediglich das

Band aus amorphem Metall strukturiert werden und kann für mehrere elektronische Bauteilpositionen einer Umverdrahtungsplatte eines Nutzens auflaminiert werden.

- 5 Um die Abschirmwirkung zu erhöhen, kann die Abschirmschicht auch mehrere gestapelte und aufeinander laminierte strukturierte Abschirmfolien aufweisen. Durch das Laminieren mehrerer Abschirmfolien übereinander kann ein beliebig hoher Abschirmfaktor erreicht werden, der für das erfindungsgemäße elektronische Bauteil zwischen 50 und 100 liegt.

Für eine wirkungsvolle magnetische Abschirmung weisen die amorphen Metalle mindestens einen der ferromagnetischen Werkstoffe Kobalt, Nickel oder Eisen auf. Als Legierungszusatz dient Bor, das ein amorphes Erstarren der ferromagnetischen Metalle fördert, so dass die kristallinen Anteile in der magnetischen Abschirmfolie vernachlässigbar gering sind.

Die Sättigungsinduktion wird bei Werten zwischen 0,5 und 1 Tesla erreicht, wobei eine Sättigungsmagnetorestriktion kleiner als $0,2 \times 10^{-6}$ vorliegt. Die magnetische Abschirmschicht der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte ist mechanisch äußerst formstabil und weichmagnetisch wirkungsvoll. Die Curietemperatur liegt zwischen 200°C und 500°C, so dass auch bei Temperaturwechseltests der elektronischen Bauteile, die zwischen -50°C und 150°C durchgeführt werden, die Abschirmwirkung nicht zerstört wird.

Die strukturierte Abschirmschicht kann auf der Außenseite der Umverdrahtungsplatte, die dem Schaltungschip gegenüberliegt, angeordnet sein. Dazu weist die Abschirmschicht in Form einer Abschirmfolie mindestens Öffnungen für die in vorgegebenem Rastermaß ringförmig oder in einer Matrix angeordnete Außen-

kontakte auf. Selbst eine derart strukturierte Abschirm-
schicht verhindert einen Durchgriff von Störfeldern auf den
Schaltungschip und gewährleistet aufgrund der weichmagneti-
schen Eigenschaften der amorphen Metallschicht eine nicht be-
5 schränkte Funktionsfähigkeit des elektronischen Bauteils.

Die strukturierte Abschirmschicht kann auch näher an der
Chipseite angeordnet werden, indem die strukturierte Ab-
schirmschicht auf der Chipseite der Umverdrahtungsplatte la-
10 miniert ist. Dazu weist zumindest für Logikchips die struktu-
rierte Abschirmschicht Öffnungen für entsprechende Bondkon-
taktflächen auf. Bei Speicherchips mit oder ohne magnetischen
Speicherzellen kann die strukturierte Abschirmschicht ohne
Änderung der Struktur sowohl auf der Chipseite als auch auf
15 der Außenseite der Umverdrahtungsplatte angeordnet werden,
solange die Abschirmschicht mindestens eine Bondkanalöffnung
in der Größenordnung des Bondkanals des Schaltungs- bezie-
hungsweise Speicherchips aufweist. Bei der Anordnung auf der
Außenseite der Umverdrahtungsplatte, die gegenüber der Chip-
20 seite der Umverdrahtungsplatte liegt, können zusätzliche Öff-
nungen für das Freilegen von Außenkontaktflächen vorgesehen
werden.

Eine alternative Lösung besteht darin, dass die Abschirm-
25 schicht auf der Außenseite der Umverdrahtungsplatte lediglich
eine Bondkanalöffnung aufweist und die Oberfläche der Ab-
schirmschicht außenseitig von einer Isolierschicht bedeckt
ist, die ihrerseits die Umverdrahtungsleitungen und die Au-
ßenkontaktflächen für ein Verbinden zwischen den Kontaktflä-
30 chen des Schaltungschips und den Außenkontakten aufweist.
Diese Alternative hat gegenüber einer Abschirmschicht unmit-
telbar auf der Außenseite des elektronischen Bauteils den

Vorteil, dass keine präzisen Öffnungen für das Freilegen von Außenkontaktflächen vorzusehen sind.

Die Abschirmwirkung der Abschirmfolien aus amorphen Metallen
5 oder Metall-Legierungen kann dadurch verstärkt werden, dass
zusätzlich zu der Umverdrahtungsplatte der Schaltungschip auf
seiner passiven Rückseite ganzflächig eine Abschirmfolie aus
amorphen Metallen oder Metall-Legierungen aufweist. Durch das
Umgeben der aktiven Vorderseite des Schaltungschips, die bei
10 Speicherchips der Umverdrahtungsplatte zugewandt ist, mit
weichmagnetischen Materialien sowohl auf der passiven Rück-
seite des Schaltungschips als auch mit einer zusätzlichen
Schicht in der Umverdrahtungsplatte wird ein nahezu perfekter
Schutz vor magnetischen und elektromagnetischen Störfeldern
15 für die aktive Vorderseite des Schaltungschips und damit für
das elektronische Bauteil erreicht, ohne dass das elektroni-
sche Bauteil in ein Abschirmgehäuse eingebettet werden muss.

Ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils,
20 das eine mehrschichtige Umverdrahtungsplatte aufweist, die
mindestens einen Schaltungschip trägt und Kontaktflächen des
Schaltungschips über Umverdrahtungsleitungen der Umverdrah-
tungsplatte mit Außenkontakten des elektronischen Bauteils
verbindet, weist folgende Verfahrensschritte auf:

25
Zunächst wird eine Abschirmfolie aus amorphem Metall oder ei-
ner amorphen Metall-Legierung für einen Nutzen mit mehreren
Bauteilpositionen strukturiert. Danach erfolgt ein Auflami-
nieren der strukturierten Abschirmfolie auf die Umverdrah-
30 tungsplatte des Nutzens. Anschließend werden Schaltungschips
in den Bauteilpositionen der Umverdrahtungsplatte des Nutzens
aufgebracht und elektrisch mit der Umverdrahtungsplatte ver-
bunden. Der gesamte Nutzen wird dann mit einer Kunststoffge-

häusemasse unter Einbetten der Schaltungschips und der elektrischen Verbindungen aufgefüllt. Dabei bleibt die Unterseite oder auch Außenseite, die Außenkontaktflächen aufweist, frei von Kunststoffgehäusemasse. Als nächstes können auf dem gesamten Nutzen in den jeweiligen Bauteilpositionen des Nutzens 5 Außenkontakte auf die Außenkontaktflächen aufgebracht werden. Nach dem Aufbringen der Außenkontakte kann der Nutzen zu einzelnen elektronischen Bauteilen getrennt werden. Um die Kanten der Kunststoffgehäusemasse abzurunden oder zu entgraten 10 können Profilsägen beim Trennen der Bauteilpositionen des Nutzens zu einzelnen elektronischen Bauteilen eingesetzt werden.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass einzelne elektronische Bauteile entstehen, deren Umverdrahtungsplatte mehrlagig ist 15 und mindestens eine Abschirmschicht aus einem amorphen Metall oder einer amorphen Metall-Legierung aufweist. Dieses amorphe Metall oder diese amorphe Metall-Legierung wirken magnetisch und elektromagnetisch abschirmend und schützend für die Funktionen des Schaltungschips innerhalb des elektronischen Bauteils, ohne dass ein äußeres Abschirmgehäuse erforderlich ist. Aufgrund der weichmagnetischen Eigenschaften der ferromagnetischen amorphen Metalle beziehungsweise Metall-Legierungen wird eine verbesserte magnetische Abschirmung für 25 Wechselfelder erreicht. Diese Abschirmschicht kann wirkungsvoll kritische Magnetfelder von Transformatoren, Netzgeräten oder Gebläsemotoren im niederfrequenten Bereich abschirmen, ohne dass die magnetische Abschirmschicht aus amorphen Metallen oder amorphen Metall-Legierungen selbst auf Dauer magnetisiert wird, da das weichmagnetische Material amorpher Metalle eine niedrige Remanenz aufweist. 30

Das Strukturieren der Abschirmfolie kann mittels Stanzen von vorbestimmten Mustern von Öffnungen erfolgen. So kann in vorteilhafter Weise für jede Bauteilposition bei Schaltungschips oder bei Chips mit magnetischen Speicherzellen in die Abschirmfolie ein langgestreckter Bondkanal eingebracht beziehungsweise ausgestanzt werden, welcher der Anordnung der Kontaktflächen auf dem Speicherchip angepasst ist. Wird die Abschirmfolie hingegen auf der äußersten Seite der Umverdrahtungsplatte aufgebracht oder angeordnet, so werden zusätzliche Öffnungen zum Freilegen oder Freilassen der Außenkontaktflächen, auf die in einem späteren Schritt Außenkontakte aufgebracht werden, vorgesehen.

Das Strukturieren der Abschirmfolie kann auch mittels Laserabtrag oder Laserablation erfolgen, wobei ein Laserstrahl über jede der Bauteilpositionen einer Abschirmfolie für einen Nutzen derart gescannt wird, dass entsprechend angepasste Öffnungen entstehen. Bei Logikschaltungen sind anstelle von Bondkanälen einzelne ringförmig angeordnete Öffnungen vorzusehen, die Bondkontaktflächen auf der Umverdrahtungsplatte freigeben, wenn die Abschirmschicht oder Abschirmfolie auf der Chipseite der Umverdrahtungsplatte angeordnet wird. Wird hingegen die Abschirmfolie für die Außenseite der Umverdrahtungsplatte vorgesehen, so sind entsprechend Öffnungen für eine Matrix von Außenkontaktflächen vorzusehen, wobei die Ränder oder Wandungen dieser Öffnungen zusätzlich mit einem Lötstopplack vor Kurzschlüssen zu schützen sind.

Eine derart strukturierte und vorbereitete Abschirmfolie kann anschließend entweder auf den Isolationskörper der Umverdrahtungsplatte unmittelbar aufgebracht werden oder wenn dieser Körper bereits Umverdrahtungsleitungen aufweist, dann wird zunächst eine dünne Isolierschicht aufgebracht oder beim

Auflaminieren ein Isolierkleber eingesetzt, so dass die auf-
gebrachten Umverdrahtungsleitungen nicht durch die Abschirm-
folie kurzgeschlossen werden. Diese Isolierschicht kann auch
bereits auf der Abschirmfolie abgeschieden worden sein, wozu
5 vorzugsweise Magnesiumoxide oder Siliziumoxide oder Silizium-
nitrid eingesetzt werden. Diese Abscheidung unmittelbar auf
der Abschirmfolie kann auch noch vor dem Strukturieren der
Abschirmfolie in einer Sputteranlage erfolgen.

- 10 Um den Abschirmfaktor geeignet einzustellen, kann entweder
die Dicke der Abschirmfolie zwischen 20 und 75 Mikrometer va-
riiert werden oder es können auch mehrere Abschirmfolien auf-
einanderlaminiert werden. Da die Magnetostriktion bei amor-
phen Metallen vernachlässigbar klein ist, ist ein Aufeinan-
15 derlaminiere von Abschirmfolien unkritisch.

- Die Wirkung der Abschirmung kann auch verstärkt werden, indem
zusätzlich entweder die Rückseite des Schaltungschips oder
die aktive Vorderseite des Schaltungschips mit einer Ab-
20 schirmfolie versehen wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass
die Rückseite geschlossen von einer Abschirmfolie bedeckt
werden kann, während die aktive Vorderseite eines Schaltung-
schips eine strukturierte Abschirmfolie erfordert, die die
Kontaktflächen des Schaltungschips freilässt.

25

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es grundsätzlich
mehrere Möglichkeiten gibt, eine magnetische Abschirmung von
Schaltungschips zu erreichen.

1. Eine unmittelbare Kompensation von Magnetfeldern auf dem
30 Chip, wobei ein ungewolltes Ummagnetisieren schaltungs-
technisch vermieden wird. Ein Nachteil dieser Möglich-
keit ist der hohe schaltungstechnische Aufwand für den

Schaltungschip, der damit gleichzeitig in der Chipfläche vergrößert werden muss, was hohe Kosten verursacht.

2. Es kann der Chip direkt abgeschirmt werden, wobei direkt
5 auf den Chip eine Sputtermetallisierung aus magnetisch
leitfähigem Material aufgebracht wird. Dieses erfordert
eine höhere Komplexität bei der Chiptechnologie, da zum
Teil Materialien, wie ferromagnetisches Eisen, Nickel
oder Kobalt oder deren Legierungen zum Einsatz kommen,
10 die üblicherweise in der Halbleitertechnologie nicht
eingesetzt werden. Schließlich besteht die Möglichkeit,
wenn eine gehäusemäßige externe Abschirmung vermieden
werden soll, eine sogenannte Package-Schirmung mit Per-
malloy oder Alloy 42 vorzunehmen, das in die Kunststoff-
15 gehäusemasse eingebettet wird. Der Nachteil eines derar-
tigen abschirmenden Deckels in dem Kunststoffgehäuse
ist, dass diese magnetischen Materialien im Magnetfeld
polarisiert werden und folglich wie ein Permanentmagnet
auf den Schaltungschip einwirken und damit die Funktion
20 des Bauteils einschränken.
3. Abschirmungen, die für elektromagnetische Störungen ein-
gesetzt werden, indem dünne Kupferschichten für das
elektronische Bauteil aufgebracht werden, können bei
25 rein magnetischen Störungen im Umfeld von elektronischen
Bauteilen, wie von Transformatoren, Netzgeräten oder Ge-
bläsemotoren nicht erfolgreich eingesetzt werden, da
diese kritischen Magnetfelder im niederfrequenten Be-
reich arbeiten, während die elektromagnetischen Wellen
30 hochfrequent sind und somit andere Abschirmmechanismen
auftreten.

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, eine neuartige, magnetisch leitfähige Folie aus amorphem Metall, wie einer Bor/Eisen-Legierung oder einer Bor-Legierung mit ferromagnetischen Metallen, wie Kobalt oder Nickel, auf die Umverdrach-

5 tungsplatte eines elektronischen Bauteils aufzulaminieren. Derartige Abschirmfolien können 20 bis 75 Mikrometer dick sein und einen Abschirmfaktor zwischen 50 und 100 erreichen.

Diese erfindungsgemäße Abschirmung unterscheidet sich entscheidend von den elektromagnetischen Abschirmungen, welche
10 aus Kupfer hergestellt werden und auch von Abschirmungen, die auf Permalloyfolien basieren, welche die oben bereits erwähnten Nachteile aufweisen.

Hinzu kommt, dass Permalloyfolien eine hohe Abhängigkeit in
15 ihrer Abschirmwirkung von der Temperatur aufweisen, was bei der erfindungsgemäßen Abschirmfolie mit einer Curietemperatur zwischen 200°C und 500°C nicht der Fall ist. Ferner sind diese bekannten Folien mechanisch wenig belastbar und haben nicht die geeignete Härte, wie es die erfindungsgemäße Ab-

20 schirmfolie liefert. Für die Abschirmfolie wird erfindungsgemäß ein hochpermeables amorphes Metall verwendet, welches eine Dicke von mindestens 20 Mikrometern und höchstens von 75 Mikrometern aufweist, wobei jedoch durch Stapeln von Folien jede beliebige Dicke erreicht werden kann, zumal die Magneto-

25 striktion vernachlässigbar klein ist und somit ein Delaminieren der gestapelten Folie nicht auftritt.

Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsformen mit Bezug auf die beigelegten Figuren näher erörtert.

30 Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil einer ersten Ausführungsform der Erfindung,

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil einer zweiten Ausführungsform der Erfindung,

5

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil einer dritten Ausführungsform der Erfindung,

10 Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil einer vierten Ausführungsform der Erfindung,

15 Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil einer fünften Ausführungsform der Erfindung.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil 1 einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Das elektronische Bauteil 1 weist eine mehrschichtige Umverdrahtungsplatte 2 auf, die ein Schaltungschip 3 trägt, wobei das Schaltungschip 3 mit seiner aktiven Oberseite 18 und einer isolierenden Klebstoff-Folie 22 auf der Umverdrahtungsplatte 2 ausgerichtet und montiert ist. Die mehrschichtige Umverdrahtungsplatte 2 weist eine Trägerschicht 25 aus vernetztem Kunststoff, der durch Glasfasern oder Kohlefasern verstärkt sein kann, auf. Die Kunststoffschicht 25 trägt eine magnetische Abschirmschicht 8 aus amorphem Metall oder einer amorphen Metall-Legierung vorzugsweise auf der Basis Eisen, Kobalt oder Nickel mit Legierungszusätzen, beispielsweise aus Bor, die trotz hoher mechanischer Härte mit einem E-Modul von 150 GPa, einer Zugfestigkeit zwischen 1000 und 3000 MPa und

einer Vickershärte zwischen 900 und 1100 weichmagnetische Eigenschaften aufweist.

Die weichmagnetischen Eigenschaften schirmen den Speicherchip
5 12 von magnetischen Störfeldern, wie sie durch Transformatoren, Netzgeräte oder Gebläsemotoren in der Umgebung eines derartigen elektronischen Speicherbausteins auftreten können, ab. Aufgrund der weichmagnetischen Eigenschaften der Abschirmschicht in einer Dicke zwischen 20 und 75 Mikrometern
10 ist wegen der amorphen Materialien gewährleistet, dass diese Schicht selbst nicht dauermagnetisiert werden kann, so dass eine Beeinträchtigung des Speicherchips und seiner Funktionsfähigkeit unterbleibt.

15 Die Außenseite 10 der Umverdrahtungsplatte 2 ist in dieser Ausführungsform der Erfindung gleichzeitig die Unterseite des elektronischen Bauteils 1. Auf der Außenseite 10 der Umverdrahtungsplatte 2 sind die Außenkontakte 7 des elektronischen Bauteils 1 angeordnet, die über eine Umverdrahtungsstruktur
20 29 aus Außenkontaktflächen 28, Umverdrahtungsleitungen 6 und Bondkontaktflächen 16 über Bondverbindungen 21 in einer Bondkanalöffnung 13 mit Kontaktflächen 5 des Speicherchips 12 verbunden sind. Die äußerste Schicht der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 2 wird von einer Lötstopplackschicht 27
25 gebildet, welche die Umverdrahtungsleitungen 6 abdeckt und die Außenkontakte 7 beziehungsweise die Außenkontaktflächen 28 freilässt.

Die Bondverbindungen 21 im Bondkanal sind in einer Kunststoffgehäusemasse 19 eingebettet und so vor mechanischen und elektrischen Störungen geschützt. Der Schichtaufbau der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte vom Speicherchip aus gesehen
30 weist somit zunächst eine Klebstoff-Folie 22, anschließend

die magnetische Abschirmschicht 8, die in diesem Fall aus einer Abschirmfolie 9 besteht, auf und wird von einer Kunststoffschicht 25 getragen, die ihrerseits mit einer Kupferstruktur 26 plattiert ist und als abschließende Außenschicht schützt eine Lötstopplackschicht 27 die Umverdrahtungsstruktur 29 der Umverdrahtungsplatte 2 vor äußerer Beschädigung und vor elektrischen Kurzschlüssen sowie vor einem Benetzen durch das Außenkontaktmaterial der Außenkontakte 7 beim Auflöten auf eine übergeordnete Schaltung einer Leiterplatte.

10

Während das Bezugszeichen 10 die Unterseite des elektronischen Bauteils 1 und gleichzeitig die Außenseite der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 2 kennzeichnet, wird die Chipseite der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 2 durch das Bezugszeichen 15 gekennzeichnet. Der Speicherchip 12 ist in dieser Ausführungsform der Erfindung in eine Kunststoffgehäusemasse 19 eingebettet. Diese Kunststoffgehäusemasse 19 kann gleichzeitig für mehrere elektronische Bauteile, die auf einem Nutzen hergestellt werden, auf den Halbleiterchip aufgebracht werden, wobei gleichzeitig auch die Kunststoffgehäusemasse 19 in die Bondkanalöffnung eingebracht wird. Die Bondkanalöffnung 13 für die einzelnen Schichten 22, 8 und 25 können in jede Schicht einzeln vor einem Auflaminieren der Schichten in dieselben eingebracht werden, wenn diese Schichten als eigenständige Folien oder Platten vorliegen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, nach Laminieren dieser drei Grundschichten 22, 8 und 25 die Bondkanalöffnung in einem Arbeitsschritt einzubringen.

20

25

30

Da sich jedoch die Materialien einer Klebstoff-Folie 15 für die Klebstoffschicht 24 der Umverdrahtungsplatte 2 und die Materialien der Abschirmfolie 9 für die Abschirmschicht 8 sowie die Materialien der Kunststoffschicht für die Trägerplat-

te wesentlich in ihrer Bearbeitbarkeit voneinander unterscheiden, werden diese drei Schichten in Folienform vorstrukturiert und anschließend aufeinander auflaminiert. Dabei weist die Kunststoffschicht 25 bereits die Umverdrahtungsstruktur 29 auf, die ihrerseits bereits mit einer Lötstopplackschicht 27 versehen sein kann. Der Schutz vor magnetischen Störfeldern erfolgt in dieser Ausführungsform der Erfindung lediglich durch die Abschirmschicht 8 der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 2, so dass der Schaltungschip 3 nur einseitig vor magnetischen Störfeldern geschützt ist.

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil einer zweiten Ausführungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

Der Aufbau der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 2 der zweiten Ausführungsform der Erfindung entspricht der Umverdrahtungsplatte 2 der ersten Ausführungsform der Erfindung, da auch hier ein Speicherchip 12, der beispielsweise auch einen magnetischen Speicherchip darstellen kann, vor magnetischen Störfeldern geschützt werden soll. Im Unterschied zur ersten Ausführungsform ist in dieser zweiten Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass eine nicht strukturierte Abschirmfolie 9 auf die passive Rückseite 17 des Speicherchips 12 laminiert wird. Damit ist die empfindliche aktive Vorderseite 18 des Halbleiterchips von Abschirmfolien 9 eingeschlossen, die einerseits auf der Rückseite des Halbleiterchips angeordnet sind und andererseits eine Schicht der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 2 bilden.

Ein weiterer Unterschied dieser zweiten Ausführungsform der Erfindung zur ersten Ausführungsform der Erfindung besteht in der Verwendung eines flachen Bondbandes für die Bondverbindung 21 in der Bondkanalöffnung 13. Dieses Bondband von unter 10 Mikrometern Dicke ist praktisch eine Verlängerung der Leiterbahn 6 der Umverdrahtungsstruktur 29. Neben dem Vorteil des beidseitigen Abschirmens der aktiven Vorderseite 18 des Speicherchips 12 durch ein amorphes Metall oder eine entsprechende amorphe Metall-Legierung wie in der ersten Ausführungsform der Erfindung, hat dieses elektronische Bauteil 1 den weiteren Vorteil, dass die Bondverbindung 21 wesentlich flacher ausgeführt werden kann als in der ersten Ausführungsform der Erfindung.

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil 1 einer dritten Ausführungsform der Erfindung. Auch in diesem Fall soll ein Speicherchip mit elektronischen Speicherzellen oder ein Speicherchip mit magnetischen Speicherzellen vor Störfeldern geschützt werden. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

Die Anordnung der Schichten in der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 2 ist in dieser Ausführungsform der Erfindung geändert, so dass die Abschirmschicht 8 in Form einer Abschirmfolie 9 auf der Außenkontaktseite der Umverdrahtungsplatte 2 angeordnet ist und die Kunststoffschicht 25 auf der Chipseite 15 der Umverdrahtungsplatte liegt. Dazu weist die Abschirmschicht 8 eine zusätzliche Isolierschicht 30, beispielsweise aus einem Ormocermaterial auf, die wenige Mikrometer dick ist und ihrerseits die Umverdrahtungsstruktur 29 trägt, auf der wiederum die Lötstopplackschicht aufgebracht ist.

Darüber hinaus wurden weitere Abschirmfolien 9 zur magnetischen Abschirmung des Speicherchips 12 vorgesehen, indem sowohl auf der Rückseite 17 des Speicherchips 12 eine nicht
5 strukturierte Abschirmfolie 9 auflaminiert ist, als auch auf der Vorderseite 18 des Speicherchips 12 eine mit einer Bondkanalöffnung 13 strukturierte Abschirmfolie 9 auflaminiert ist. Derartige zusätzliche Abschirmschichten 8 unmittelbar auf dem Speicherchip sind dann hilfreich, wenn der Abschirmfaktor der Abschirmschicht 8 aus amorphem Metall oder einer
10 Metall-Legierung in der Umverdrahtungsplatte 2 nicht ausreicht.

Alternativ kann die Abschirmschicht 8 in der Umverdrahtungsplatte 2 auch mehrlagig ausgeführt werden, indem mehrere Abschirmfolien 9 übereinander laminiert werden. Doch kann ein
15 derartiger Stapel in der Umverdrahtungsplatte 2 nicht den Speicherchip 12 vor magnetischen Störungen von der Rückseite 17 aus schützen, so dass das Auflaminieren eines Stapels von Abschirmfolien 9 auf der Rückseite 7 des Speicherchips 12 in
20 Fällen großer magnetischer Störfelder erforderlich werden kann.

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil 1 einer vierten Ausführungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.
25

30 Der mit der vierten Ausführungsform der Erfindung zu schützende Schaltungschip 3 ist ein Logikchip 14, der mit seiner aktiven Oberseite 18 nicht zu der Umverdrahtungsplatte 2 gerichtet ist, sondern entgegengesetzt angeordnet ist, so dass

seine passive Rückseite 17 auf der Umverdrahtungsplatte 2 über eine in diesem Fall elektrisch leitende Klebstoffschicht 23 verbunden ist. Die mehrschichtige Umverdrahtungsplatte 2 weist zur Chipseite 15 hin eine strukturierte Abschirmschicht 8 in Form einer Abschirmfolie 9 auf, die derart strukturiert ist, dass sie Öffnungen 11 für Bondkontaktflächen 16 einer Umverdrahtungsstruktur 29 freigibt. Die Abschirmschicht 8 aus amorphem Metall ist mit Hilfe eines isolierenden Klebstoffs beziehungsweise einer isolierenden Klebstoffschicht 24 auf die Umverdrahtungsstruktur 29 der Kunststoffschicht auflaminiert.

Die Kunststoffschicht 25 weist in dieser vierten Ausführungsform der Erfindung Durchkontakte 31 auf, über welche die Umverdrahtungsstruktur 29 elektrisch mit den Außenkontakten 7 verbunden ist. Über einen derartigen Durchkontakt 31 kann auch die Rückseite 17 des Logikchips 14 mit einem Außenkontakt 7 beispielsweise zur Erdung oder zum Anschluss an das niedrigste Potential der integrierten Schaltung des Logikchips 14 verbunden sein. Diese elektrische Verbindung wird über die Umverdrahtungsfolie 9 auf der Rückseite 17 des Halbleiterchips, eine elektrisch leitende Klebstoffschicht 23, eine weitere Abschirmfolie 9 aus elektrisch leitendem, magnetisch abschirmenden amorphem Metall oder einer entsprechenden Metall-Legierung und schließlich über elektrische Kontaktflächen aus Kupfer und entsprechenden Lotflächen sowie über einen Durchkontakt 31 und eine Außenkontaktfläche 28 zu dem Außenkontakt 7 erreicht.

Somit ist die Unterseite des Logikchips 14 mit zwei aufeinander gestapelten Abschirmfolien 9, die über einen leitenden Klebstoff 23 miteinander verbunden sind, vor magnetischen Störungen geschützt, während die aktive Oberseite 18 durch

eine strukturierte Abschirmfolie 9 zusätzlich geschützt werden kann. Diese strukturierte Abschirmfolie 9 weist Öffnungen 11 zur Freilassung der Kontaktflächen 5 des Logikchips 14 auf, so dass für eine Bondverbindung 21 diese Kontaktflächen 5 des Logikchips 14 am Rand des Logikchips zugänglich sind.

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil 1 einer fünften Ausführungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Ausführungsformen werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

Der Unterschied der fünften Ausführungsform der Erfindung zu der vierten Ausführungsform der Erfindung besteht darin, dass eine Abschirmfolie 9 auf der Außenseite des elektronischen Bauteils angeordnet ist. Dazu weist die strukturierte Abschirmfolie 9 Öffnungen 11 für die Außenkontakte 7 auf. Zusätzlich werden die Außenkontakte 7 von einem Lötstopplack 11 umgeben, der die Außenkontakte 7 gleichzeitig von der Abschirmfolie 9 auf der Unterseite des elektronischen Bauteils 1 isoliert. Auch in dieser Ausführungsform der Erfindung wird die Abschirmung für ein Logikchip 14 eingesetzt, das in seinem Randbereich Kontaktflächen 5 aufweist, die bei einer Abschirmung der aktiven Oberseite 18 des Halbleiterchips mit einer Abschirmfolie 9 durch entsprechende Öffnungen 11 in der Abschirmfolie ausgespart werden müssen.

Auch in dieser Ausführungsform kann die Rückseite 17 des Logikchips 14 mit einem der Außenkontakte 7 über einen Durchkontakt verbunden sein, jedoch wird dieses in dem hier dargestellten Querschnitt der Figur 5 nicht gezeigt. In einer derart einfachen Ausführungsform der Erfindung besteht die Umverdrahtungsplatte 2 lediglich aus drei Schichten, nämlich

eine Schicht, welche die Umverdrahtungsstruktur 29 mit entsprechenden Umverdrahtungsleitungen 6 aufweist, ferner eine Kunststoffschicht 25, welche die Umverdrahtungsstruktur trägt und Durchkontakte 31 aufweist, sowie eine Abschirmschicht 8
5 aus einer Abschirmfolie 9 mit entsprechenden Öffnungen 11 für die Außenkontakte 7 des elektronischen Bauteils. Auch in der fünften Ausführungsform der Erfindung wird wie in der vierten Ausführungsform der Erfindung die Verbindung zwischen Kontaktflächen 5 des Logikchips 14 mit der Umverdrahtungsstruktur
10 tur 29 über eine Bondverbindung 21 erreicht.

Patentansprüche

1. Elektronisches Bauteil (1) mit einer mehrschichtigen Um-
verdrahtungsplatte (2), die einen Schaltungschip (3)
5 insbesondere einen magnetischen Speicherchip (4) trägt
und Kontaktflächen (5) des Chips über Umverdrahtungslei-
tungen (6) mit Außenkontakten (7) des elektronischen
Bauteils (1) verbindet, wobei die Umverdrahtungsplatte
10 (2) mindestens eine strukturierte, magnetische Abschirm-
schicht (8) aus einem amorphen Metall oder einer amor-
phen Metall-Legierung aufweist.
2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
15 der Schaltungschip (3) magnetische Speicherzellen auf-
weist.
3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
20 der Schaltungschip (3) ein Logikchip (14) ist.
4. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
25 die Abschirmschicht (8) eine strukturierte Abschirmfolie
(9) mit einer Dicke zwischen 20 und 75 Mikrometer ist.
5. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
30 dadurch gekennzeichnet, dass
die Abschirmschicht (8) mehrere gestapelte und aufeinan-
der laminierte Abschirmfolien (9) aufweist.
6. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
35 dadurch gekennzeichnet, dass

das amorphe Metall eine Kobalt oder Kobaltlegierung aufweist.

5 7. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das amorphe Metall eine Bor/Eisen-Legierung aufweist.

10 8. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das amorphe Metall eine Sättigungsinduktion zwischen 0,5 und 1 Tesla aufweist.

15 9. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das amorphe Metall eine Sättigungsmagnetostriktion kleiner als $0,2 \times 10^{-6}$ aufweist.

20 10. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das amorphe Metall eine Curietemperatur zwischen 200°C und 500°C aufweist.

30 11. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die strukturierte Abschirmschicht (8) auf der Außenseite (10) der Umverdrahtungsplatte (2), die dem Schaltungschip (3) gegenüberliegt, angeordnet ist, wobei die Abschirmfolie (9) mindestens Öffnungen (11) für in vorgegebenem Rastermaß ringförmig oder in einer Matrix angeordnete Außenkontakte (7) aufweist.

12. Elektronisches Bauteil nach einem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die strukturierte Abschirmschicht (8) der Umverdrahtungsplatte (2) eines Speicherchips (12) mindestens eine Bondkanalöffnung aufweist.
13. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die strukturierte Abschirmschicht (8) auf der Chipseite (15) der Umverdrahtungsplatte (2) angeordnet ist und mindestens Öffnungen (11) für Bondkontaktflächen (16) aufweist.
14. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schaltungschip (3) auf seiner Rückseite (17) eine Abschirmfolie (9) aufweist.
15. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schaltungschip (3) auf seiner aktiven Vorderseite (18) eine strukturierte Abschirmfolie (9), in der mindestens Öffnungen (11) für die Kontaktflächen (5) der Schaltungschips (3) vorgesehen sind, aufweist.
16. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abschirmschicht (8) auf der Umverdrahtungsplatte (2) mindestens einen Schirmfaktor zwischen 50 und 100 aufweist.

17. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils (1), das eine mehrschichtige Umverdrahtungsplatte (2) aufweist, die mindestens einen Schaltungschip (3) trägt und Kontaktflächen (5) des Schaltungschips über Umverdrahtungsleitungen (6) mit Außenkontakten (7) des elektronischen Bauteils (1) verbindet, wobei die Umverdrahtungsplatte (2) mindestens eine strukturierte, magnetische Abschirmschicht (8) aus einem amorphen Metall oder einer amorphen Metall-Legierung aufweist, wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte aufweist:

- Strukturieren einer Abschirmfolie (8) aus amorphem Metall oder einer amorphen Metall-Legierung für einen Nutzen mit mehreren Bauteilpositionen,
- Auflaminieren der strukturierten Abschirmfolie (8) auf die Umverdrahtungsplatte (2) des Nutzens,
- Aufbringen und elektrisches Verbinden von Schaltungschips (23) in den Bauteilpositionen der Umverdrahtungsplatte (2) des Nutzens,
- Aufbringen einer Kunststoffgehäusemasse (19) auf den Nutzen unter Einbetten der Schaltungschips (3) und der elektrischen Verbindungen (20),
- Aufbringen von Außenkontakten (7) in den Bauteilpositionen des Nutzens,
- Vereinzeln der Bauteilpositionen des Nutzens zu einzelnen elektronischen Bauteilen (1).

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Strukturieren der Abschirmfolien (9) mittels Stanzen von vorbestimmten Mustern von Öffnungen (11) erfolgt.

19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Strukturieren der Abschirmfolien (9) mittels Laserabtrag erfolgt.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Strukturieren der Abschirmfolien (9) mittels Ätzver-
fahren durch eine Ätzmaske erfolgt.

5

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
die strukturierte Abschirmfolie (9) vor dem Aufbringen
der Schaltungschips (3) auf die Chipseite (15) der Um-
verdrahtungsplatte (2), welche die Schaltungschips (3)
trägt, unter Freilassung der für die Bondverbindungen
(21) vorgesehenen Flächen auflaminiert wird.

10

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
die strukturierte Abschirmfolie (9) auf die Außenseite
(10) der Umverdrahtungsplatte (2), welche die Außenkon-
takte (7) trägt, unter Freilassung der für die Außenkon-
takte (7) vorgesehenen Flächen auflaminiert wird.

15

20

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass
in den Bauteilpositionen des Nutzens Schaltungschips (3)
mit magnetischen Speicherzellen auf die Umverdrahtungs-
platte (2) aufgebracht werden.

25

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass
in den Bauteilpositionen des Nutzens Schaltungschips (3)
mit Logikschaltungen auf die Umverdrahtungsplatte (2)
aufgebracht werden.

30

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere strukturierte Abschirmfolien (9) aufeinander la-
miniert werden.

35

26. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 25,
dadurch gekennzeichnet, dass
vor dem Aufbringen der Schaltungschips (3) auf die Um-
verdrahtungsplatte (2) auf den Rückseiten (17) der
5 Schaltungschips (3) Abschirmfolien (9) aufgebracht wer-
den.

27. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 26,
dadurch gekennzeichnet, dass
10 vor dem Aufbringen der Schaltungschips (3) auf die Um-
verdrahtungsplatte (2) auf der aktiven Vorderseite (18)
der Schaltungschips (3) strukturierte Abschirmfolien (9)
unter Freilassen der Kontaktflächen (5) der Schaltung-
schips (3) aufgebracht werden.

15

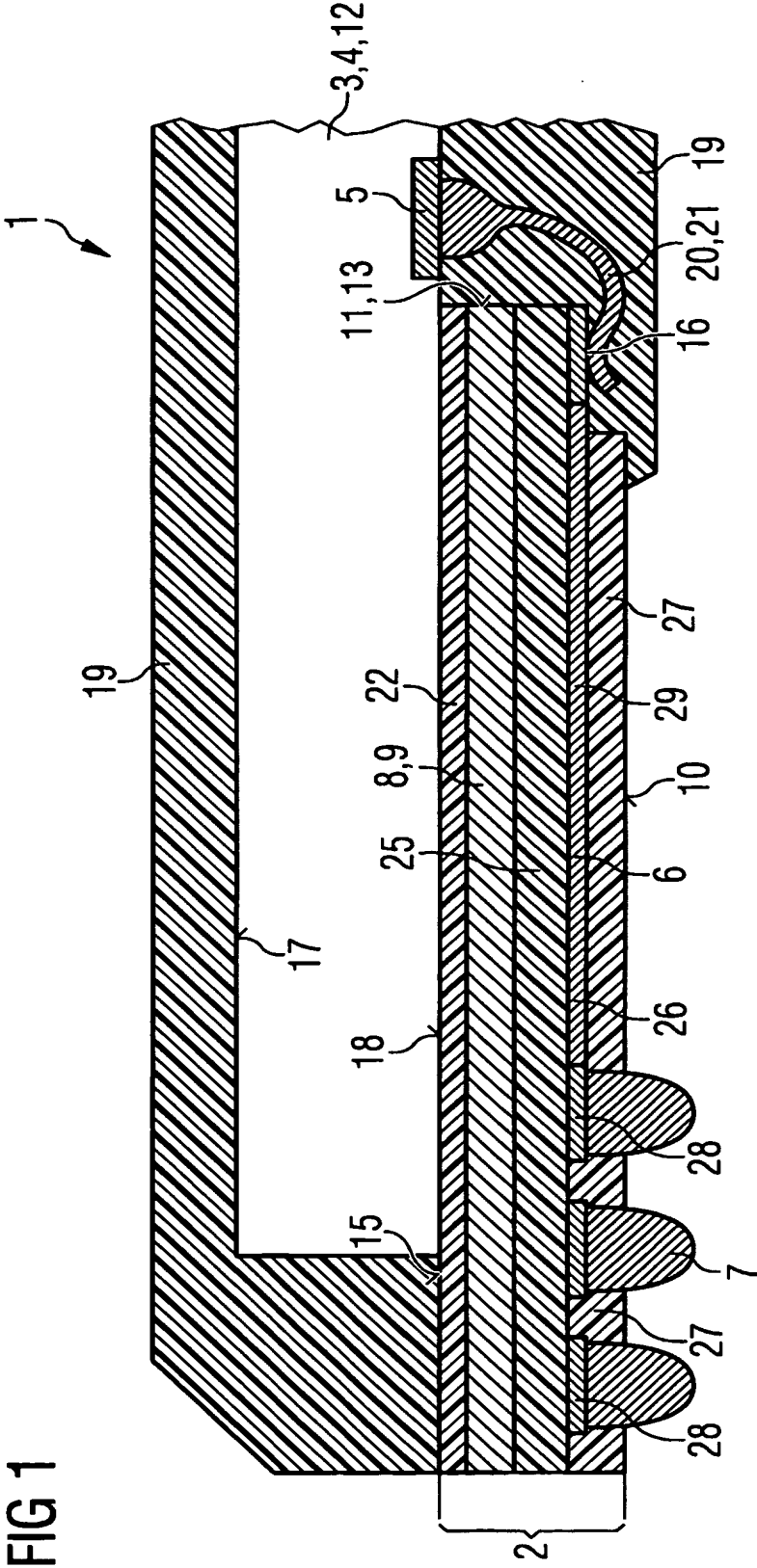
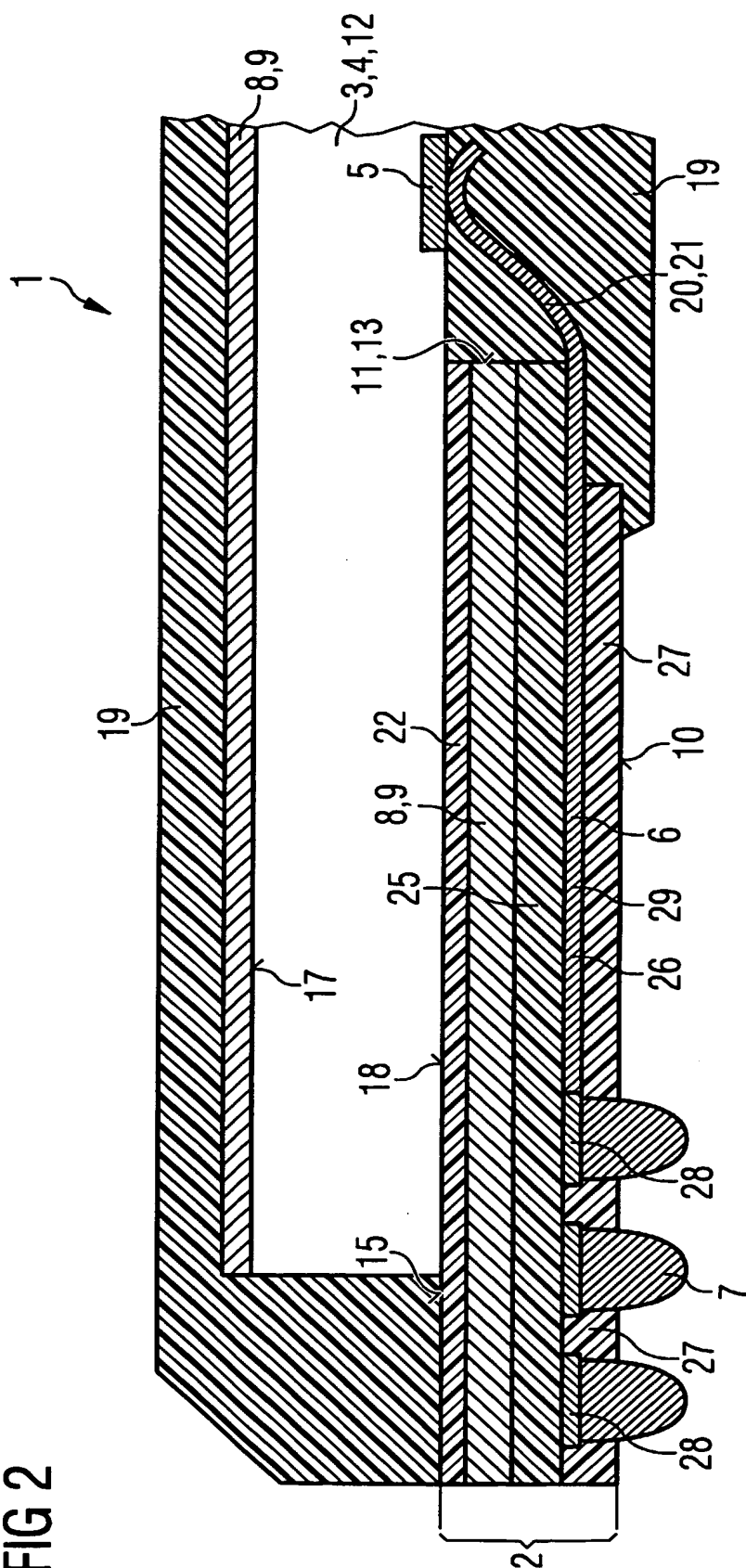


FIG 1

FIG 2



3/5

FIG 3

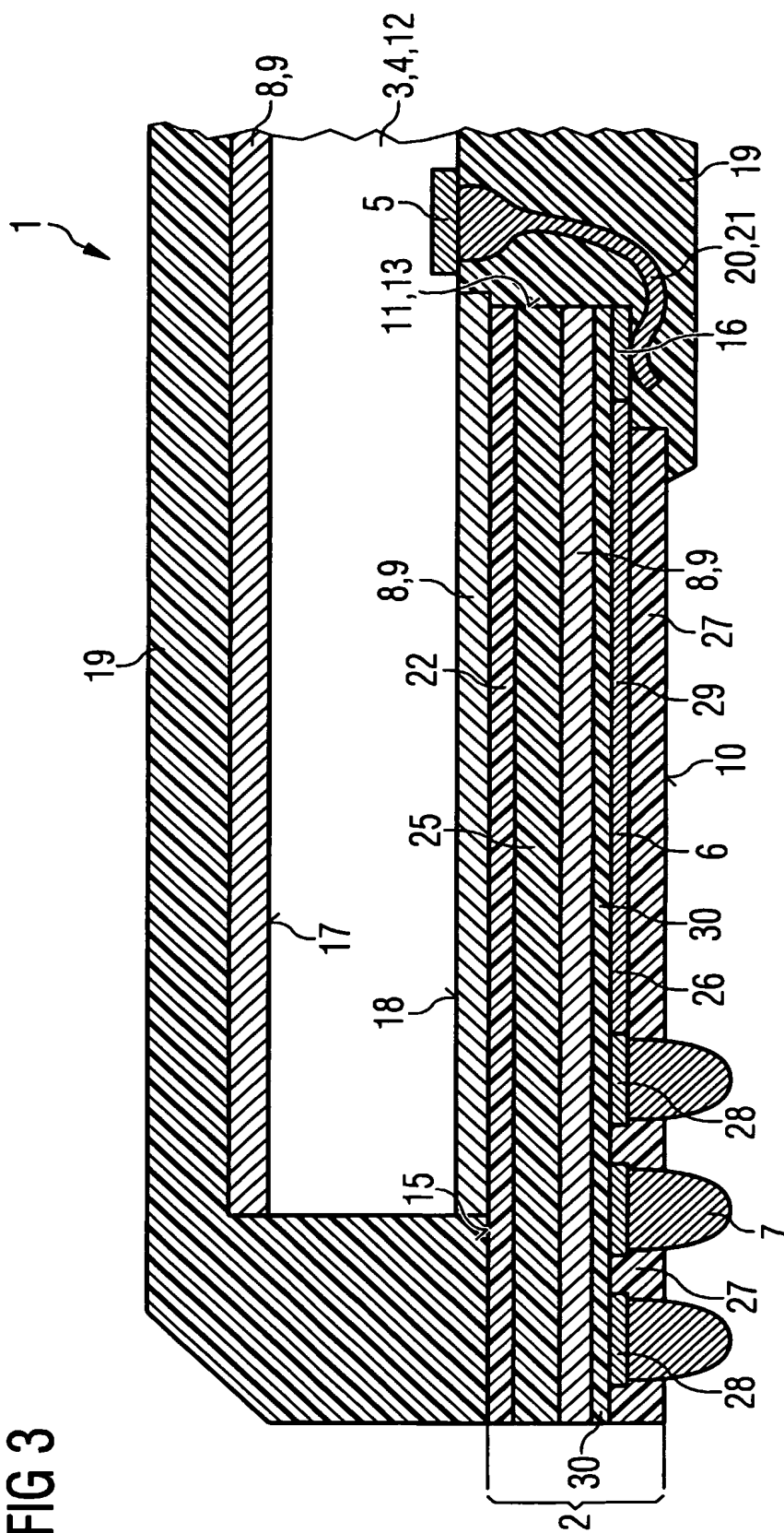
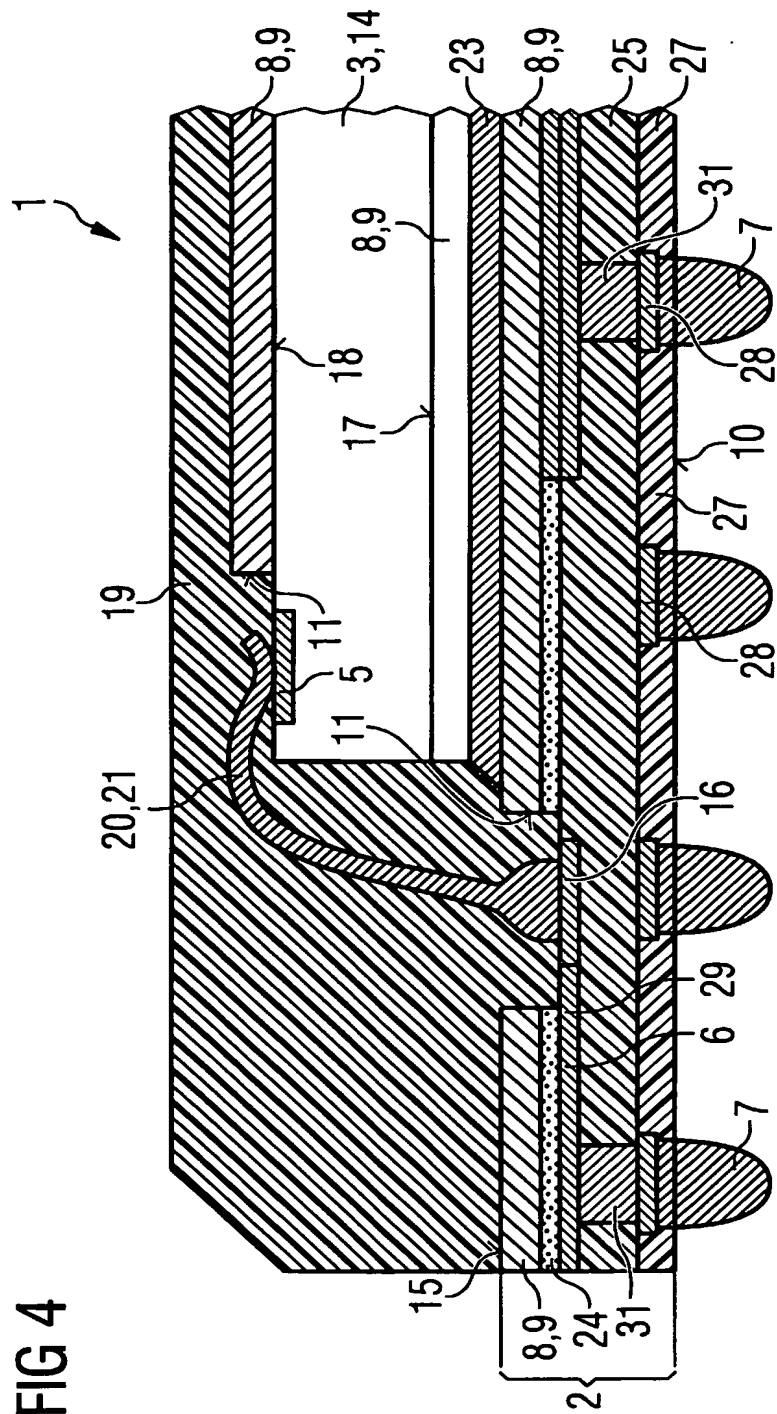
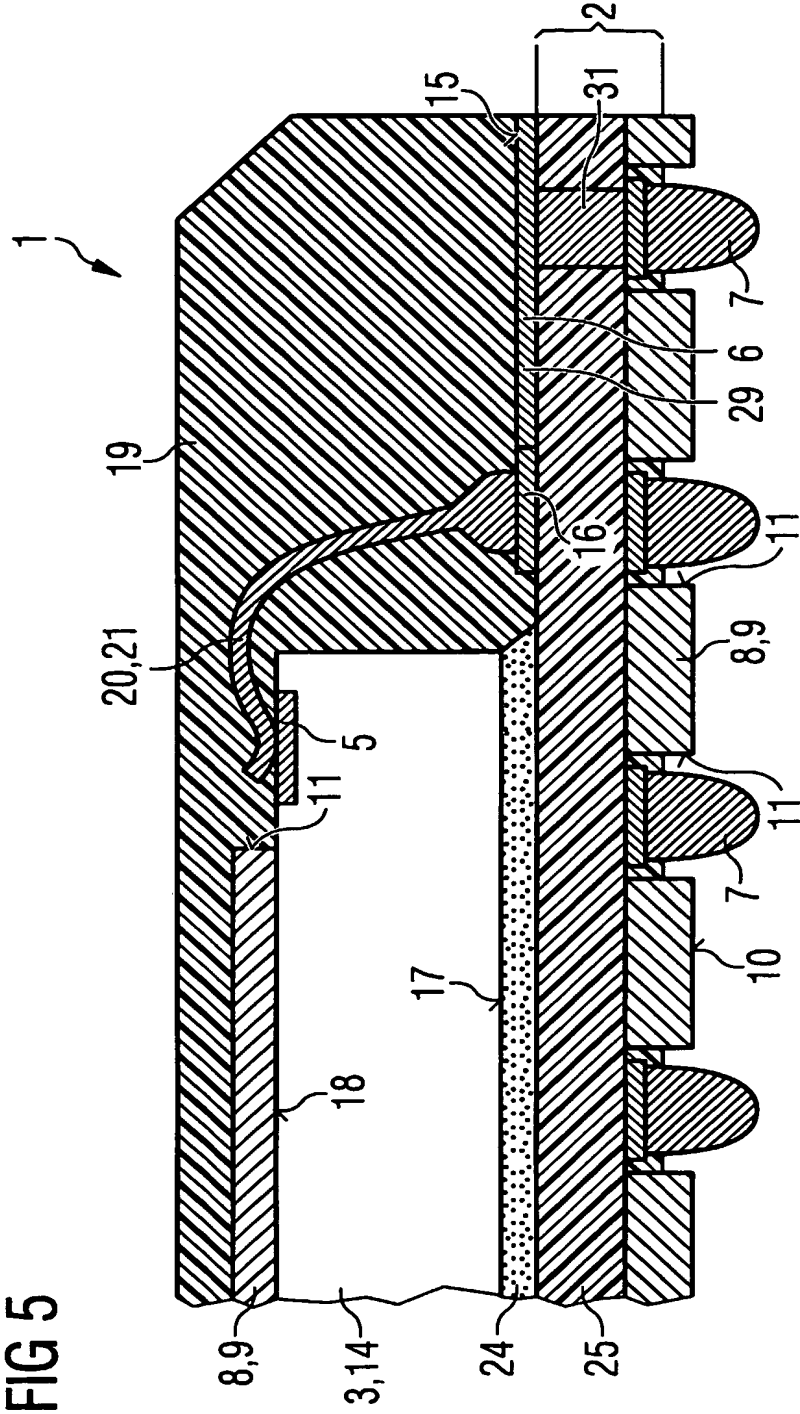


FIG 4





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/02162

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H01L23/552 H01L23/498 G11C11/15

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01L G11C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 2002/050632 A1 (TUTTLE MARK) 2 May 2002 (2002-05-02) paragraphs '0026!', '0034!'; figure 6 ---	1-17, 21-27
Y	GROSSINGER R ET AL: "Magnetic characterization of soft magnetic materials-experiments and analysis", JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, VOL. 254-255, PAGE(S) 7-13 XP004396464 ISSN: 0304-8853 the whole document ---	1-17, 21-27
Y	US 2002/081772 A1 (PALACPAC DIOSDADO ET AL) 27 June 2002 (2002-06-27) figures 3-8 --- -/--	17, 21-27



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 December 2003

Date of mailing of the international search report

12/12/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Ahlstedt, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/02162

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 08, 6 August 2003 (2003-08-06) -& JP 2003 115578 A (CANON INC), 18 April 2003 (2003-04-18) paragraph '0051! ---	1,2, 6-10, 14-16
A	EP 0 785 557 A (TOKIN CORP) 23 July 1997 (1997-07-23) page 1, line 11 - line 16; figure 10 ---	1,5,17
A	US 4 642 716 A (AKIYAMA KATSUHIKO ET AL) 10 February 1987 (1987-02-10) column 5, line 39 - line 55 ---	1-27
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 541 (E-854), 5 December 1989 (1989-12-05) -& JP 01 223708 A (TOKIN CORP), 6 September 1989 (1989-09-06) abstract -----	1-27

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/DE 03/02162

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2002050632 A1	02-05-2002	US 2002105058 A1 US 2003052340 A1	08-08-2002 20-03-2003
US 2002081772 A1	27-06-2002	NONE	
JP 2003115578 A	18-04-2003	NONE	
EP 0785557 A	23-07-1997	JP 9035927 A DE 69604771 D1 DE 69604771 T2 EP 0785557 A1 HK 1001438 A1 KR 267358 B1 CN 1165579 A WO 9704469 A1	07-02-1997 25-11-1999 09-03-2000 23-07-1997 14-07-2000 16-10-2000 19-11-1997 06-02-1997
US 4642716 A	10-02-1987	JP 59079417 A CA 1209259 A1 DE 3339037 A1 FR 2535500 A1 GB 2130425 A ,B NL 8303708 A	08-05-1984 05-08-1986 03-05-1984 04-05-1984 31-05-1984 16-05-1984
JP 01223708 8 A		NONE	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 H01L23/552 H01L23/498 G11C11/15

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01L G11C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 2002/050632 A1 (TUTTLE MARK) 2. Mai 2002 (2002-05-02) Absätze '0026!', '0034!'; Abbildung 6 ---	1-17, 21-27
Y	GROSSINGER R ET AL: "Magnetic characterization of soft magnetic materials-experiments and analysis", JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, VOL. 254-255, PAGE(S) 7-13 XP004396464 ISSN: 0304-8853 das ganze Dokument ---	1-17, 21-27
Y	US 2002/081772 A1 (PALACPAC DIOSDADO ET AL) 27. Juni 2002 (2002-06-27) Abbildungen 3-8 --- -/--	17, 21-27

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

4. Dezember 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

12/12/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5816 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Ahlstedt, M

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P,X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 08, 6. August 2003 (2003-08-06) -& JP 2003 115578 A (CANON INC), 18. April 2003 (2003-04-18) Absatz '0051! ----	1,2, 6-10, 14-16
A	EP 0 785 557 A (TOKIN CORP) 23. Juli 1997 (1997-07-23) Seite 1, Zeile 11 - Zeile 16; Abbildung 10 ----	1,5,17
A	US 4 642 716 A (AKIYAMA KATSUHIKO ET AL) 10. Februar 1987 (1987-02-10) Spalte 5, Zeile 39 - Zeile 55 ----	1-27
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 541 (E-854), 5. Dezember 1989 (1989-12-05) -& JP 01 223708 A (TOKIN CORP), 6. September 1989 (1989-09-06) Zusammenfassung -----	1-27

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die derselben Patentfamilie gehören

Internationales Patentzeichen

PCT/DE 03/02162

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002050632 A1	02-05-2002	US 2002105058 A1 US 2003052340 A1	08-08-2002 20-03-2003
US 2002081772 A1	27-06-2002	KEINE	
JP 2003115578 A	18-04-2003	KEINE	
EP 0785557 A	23-07-1997	JP 9035927 A DE 69604771 D1 DE 69604771 T2 EP 0785557 A1 HK 1001438 A1 KR 267358 B1 CN 1165579 A WO 9704469 A1	07-02-1997 25-11-1999 09-03-2000 23-07-1997 14-07-2000 16-10-2000 19-11-1997 06-02-1997
US 4642716 A	10-02-1987	JP 59079417 A CA 1209259 A1 DE 3339037 A1 FR 2535500 A1 GB 2130425 A , B NL 8303708 A	08-05-1984 05-08-1986 03-05-1984 04-05-1984 31-05-1984 16-05-1984
JP 01223708 8 A		KEINE	